








	<h2 style="color: red;">JAN1N5553US</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">JAN1N5553US</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Microsemi</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 800V 3A B-MELF</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">JAN1N5553US.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	JAN1N5553US
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 800V 3A B-MELF
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Dioden-Gleichrichter</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.3V @ 9A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	800V
Supplier Device-Gehäuse	D-5B
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/420
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	2µs
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, B
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	1µA @ 800V
Strom - Richt (Io)	3A
Kapazität @ Vr, F	-

JAN1N5553US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N5553US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N5553US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JAN1N5553US E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>JAN1N5552US</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 600V 3A B-MELF</p>	 <p><b>JAN1N5551US</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 3A B-MELF</p>	 <p><b>JAN1N5554</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1KV 3A AXIAL</p>	 <p><b>JAN1N5553</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 3A AXIAL</p>
 <p><b>JAN1N5552</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 600V 3A AXIAL</p>	 <p><b>JAN1N5554US</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1KV 5A D5B</p>	 <p><b>JAN1N5552US</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 600V 3A B-MELF</p>	 <p><b>JAN1N5555</b> Microsemi Corporation TVS DIODE 30.5VWM 47.5VC DO13</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JAN1N5553US Microsemi	JAN1N5553US Datenblatt	JAN1N5553US-Datenblätter	JAN1N5553US PDF	Microsemi JAN1N5553US
JAN1N5553US Electronic	JAN1N5553US-Komponenten	JAN1N5553US-Verteiler	JAN1N5553US-Bild	JAN1N5553US-Teil
JAN1N5553US Preis	JAN1N5553US Hersteller	JAN1N5553US Bild	JAN1N5553US Aktie	JAN1N5553US Inventar
JAN1N5553US Neu	JAN1N5553US Original	JAN1N5553US garantiert	JAN1N5553US RFQ	JAN1N5553US Online bestellen